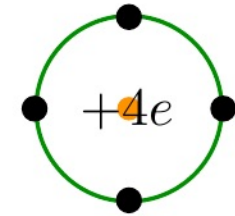
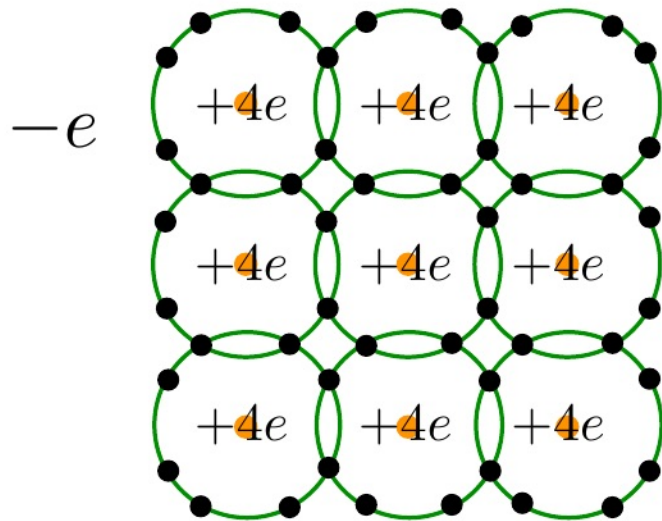


p型半導体の作り方

電氣的に中性



真性半導体 Si (4価) 結晶

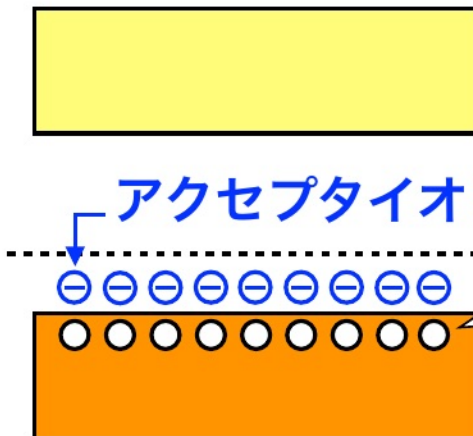
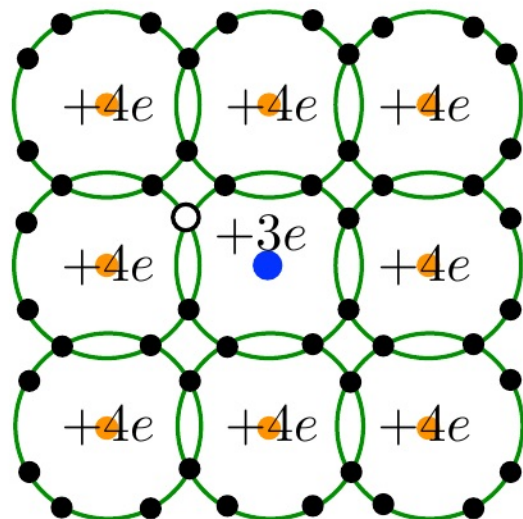


共有結合により
価電子帯の電子は
埋まっている

不純物濃度を

10^{13} 個/cm³から 10^{20} 個/cm³
程度まで変化させる

p型半導体 3価の元素 (不純物) をドーピング



共有結合の一つの
電子が足りなくなる



価電子帯に**正孔**が存在